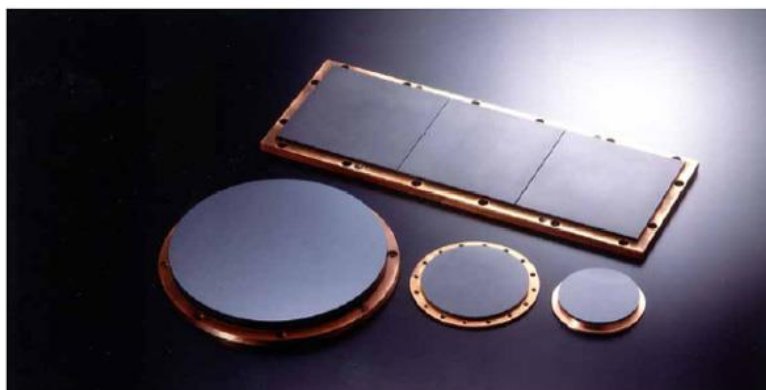


# Advansic 高純度SiCスパッタリングターゲット

## SiC Pulse heat tools

### 特徴

- DC(直流)方式による高速SiC成膜が可能  
(RFスパッタリング方式の2倍の成膜速度)
- 均質、緻密な膜が得られ易い
- ダストやパーティクルの発生が少ない
- 大出力スパッタが可能



### 特性

グレード	SSC				CSI
コード番号	S312	S314	S511	S452	S202
結晶型	$\beta$ -SiC	$\beta$ -SiC	$\beta$ -SiC*	$\alpha$ -SiC	$\beta$ -SiC,C
密度 kg/m <sup>3</sup> × 10 <sup>3</sup>	3.19	3.18	3.18	3.20	2.50
4点曲げ強度 Mpa(室温)	520	650	470	490	160
ピッカース硬度	2700	2270	2250	2700	—
ヤング率 Gpa	420	420	410	430	—
線熱膨張係数 × 10 <sup>-6</sup> (1073K)	4.0	4.9	4.9	4.8	—
熱伝導率 W/m·K(室温)	194	190	190	247	60
比抵抗 $\Omega \cdot m \times 10^{-2}$ (室温)	0.01	0.006	0.03	130	0.005

\* Include  $\alpha$ -SiC

### 材料グレード・成膜用途例

- SSCグレード(SiC成膜) : 耐摩耗性、耐食性、高屈折率、高密着コーティング
- CSIグレード(SiC + カーボン成膜) : 耐摩耗性、低摩擦、高密着コーティング